

2SC97A

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高速度スイッチング, 高周波増幅用 /

High Speed Switching, High Frequency Amplifier

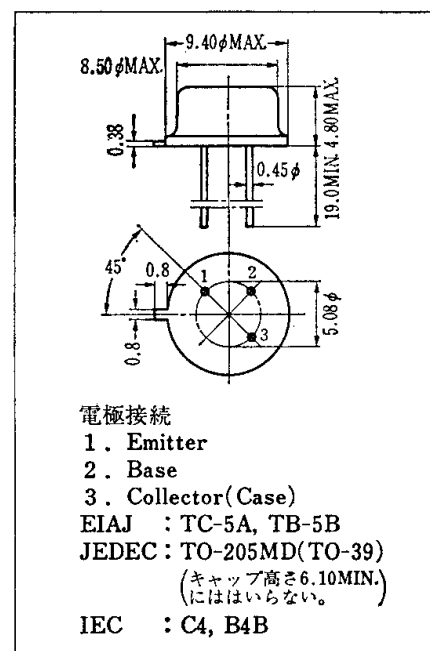
通信工業用 / Industrial Use

特 徴 / FEATURES

- ・800mA くらいまでの高速スイッチングが可能です。
Large current high speed swiching.
- ・コレクタ飽和電圧が小さい。 $V_{CE(sat)}$: 0.2V TYP. ($I_C=500mA$)
Low collector saturation voltage.
- ・コレクタ・エミッタ間耐圧が大きい。 V_{CEO} : 45V
High collector emitter breakdown voltage.
- ・2SA571 とのコンプリメンタリ用です。
Complementary with 2SA571.

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	45	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	1.0	A
全損失	$P_T(T_a=25^\circ C)$	0.8	W
全損失	$P_T(T_C=25^\circ C)$	5.0	W
ジャンクション温度	T_j	175	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ C$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CES}	$V_{CE}=45V, V_{BE}=0$			0.5	μA
エミッタ電流増幅率	I_{EBO}	$V_{EB}=4.0V, I_C=0$			0.5	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=10V, I_C=50mA$	40	80	160	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=1.0V, I_C=500mA$	40			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$		0.2	0.6	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$		0.9	1.2	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10V, I_F=-50mA$	250	350		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz$		6.0	10	pF
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=500mA, I_{B1} \doteq -I_{B2} \doteq 50mA$ 測定回路図参照 / See test circuits		15	30	ns
蓄積時間	t_{stg}			50	70	ns
ターンオフ時間	t_{off}					